旌芯半导体科技(上海)有限公司

GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN358HA

1、概述

GN358HA是由两个独立的高增益运算放大器组成。可以是单电源工作, 也可以是双电源工作,电源的功耗电流与电源电压大小无关。应用范围包括 音频放大器、工业控制、DC增益部件和所有常规运算放大电路。

主要特点

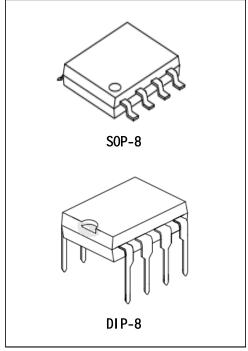
· 可单电源或双电源工作

双电源: $\pm 2 \sim \pm 16V$ 单电源: $+ 4 \sim + 32V$

- · 包含两个运算放大器
- · 逻辑电路匹配
- · 功耗小
- · 频率范围宽

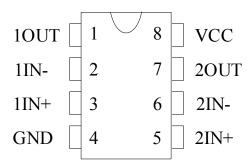
封装形式

GN358HA SOP-8 4000PCS/盘 8000PCS/盒 64000PCS/箱



2、引脚说明及功能框图

2.1、引脚排列图



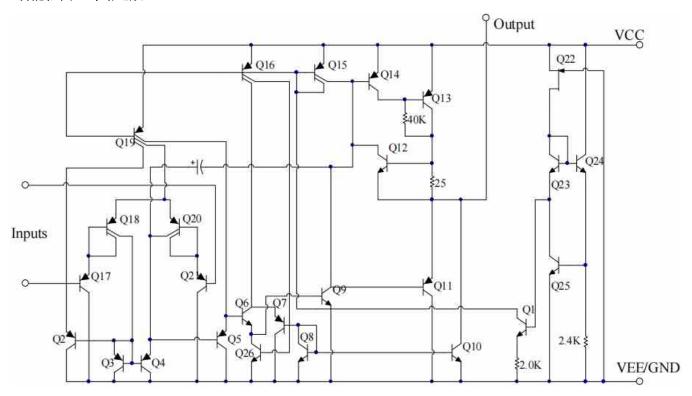
2.2、引脚说明

管脚序号	管脚名称	I/0	描述
1	10UT	0	1输出
2	1IN-	Ι	1运放负输入
3	1 IN+	Ι	1运放正输入
4	GND	_	地
5	2IN+	Ι	2运放正输入
6	2IN-	Ι	2运放负输入
7	20UT	0	2输出
8	Vcc	_	电源电压

电话:021-34125778



2.3、功能框图 (每路运放)



3、电特性

3.1、极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)

	参 数	名 称	数值	单 位
电源电压		双电源	$\pm 2 \sim \pm 16$	V
电 <i>你</i> 电压		单电源	+4~+32	V
差分输入电压		32	V	
输入电压		-0.3 ∼ VCC	V	
功耗(注 1)	DIP 封装		830	mW
切代(注 1) 	SOP 封装		530	11144
输出端对地短路區	电流 (每路放大	持续		
输入电流(VIN<-	0.3V)	50	mA	
最大工作结温		150	$^{\circ}$ C	
工作温度		-25 ~ +85	$^{\circ}$ C	
贮存温度		-65 ∼ 150	$^{\circ}$	

注 1: 不能超过最大结温。



旌芯半导体科技(上海)有限公司 GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN358HA

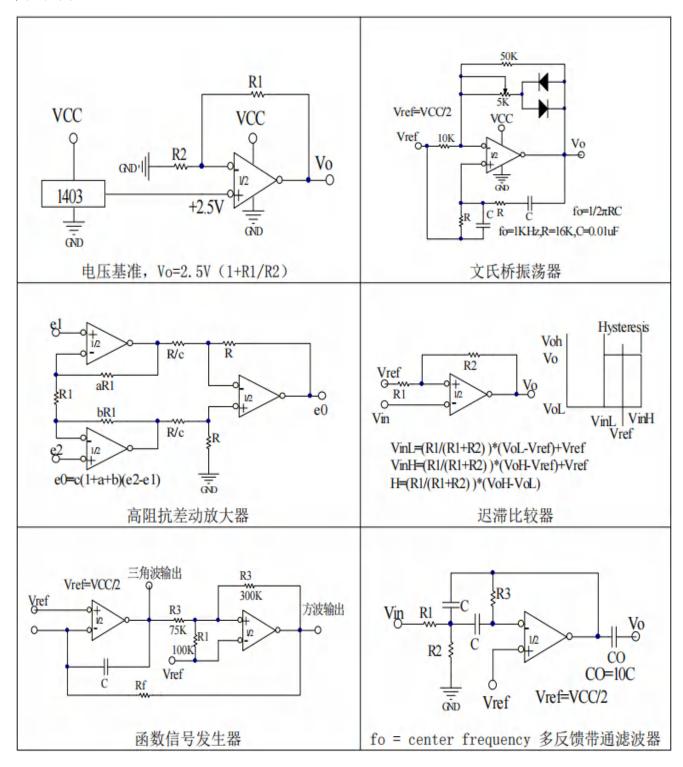
3.2、电气特性 (若无其它规定, Vcc=5.0V)

电参数		测试条件			规 范 值		
					典型	最大	位
输入失调	电压	Ta=25℃			±2	±3	mV
输入偏置	电流	Ta=25℃, IIN(+)或IIN(-), VCM=0V			±45	±250	nA
输入失调	电流	Ta=25°C, IIN(+) - IIN(-), VCM=0V			±3	±50	nA
输入共模 围	输入共模电压范 围 Ta=25℃, V ⁺ =30V			0		Vcc -1. 5	V
电源电流		RL=∞在所有运算放大器上	Vcc =30V		1	2	mA
电 <i>你</i> 电机		ILL	Vcc =5V		0.5	1.2	mA
大信号电压增益		Vcc =15V, Ta=25℃, RL≥2kΩ (对于 Vo=1~11V)			100		V/mV
共模抑制比		DC, Ta=25°C, VCM=0~Vcc-1.5V	65	90		dB	
电源抑制比		DC, Ta=25℃, Vcc =5~30V			100		dB
输出源电流		VIN(+)=1V, VIN(−)=0V, Vcc=15V, Vo=2V, Ta=25°C			40		mA
		VIN(-)=1V, $VIN(+)=0V$, $Vcc=15V$, $Vo=2V$,	10	15		mA	
输出吸电流		VIN(-)=1V, VIN(+)=0V, Vcc=15V, Vo=200 Ta=25°C	12	50		μА	
对地短路电流		Vcc=15V, Ta=25℃			40	60	mA
#A .11 .4-	VOH	Vcc=30V	RL=2kΩ	26			V
输出电压摆幅	VOII	Vcc=30V	RL=10kΩ	27	28		V
` 4 P I H	VOL	Vcc=5V, RL=10k Ω			5	20	mV



GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

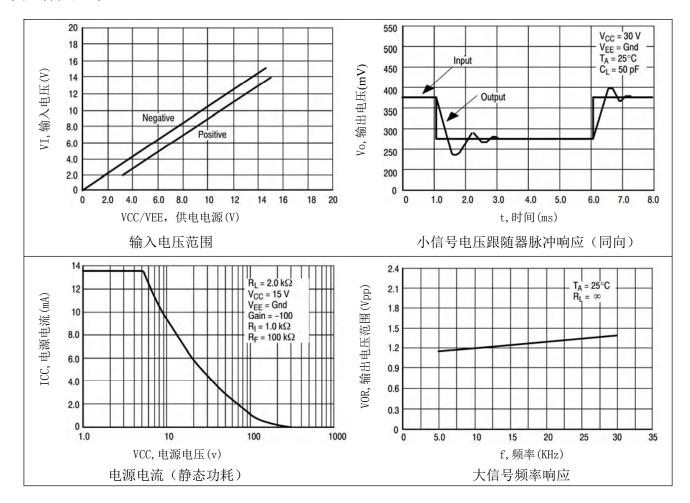
4、典型应用





GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

5、典型特性曲线

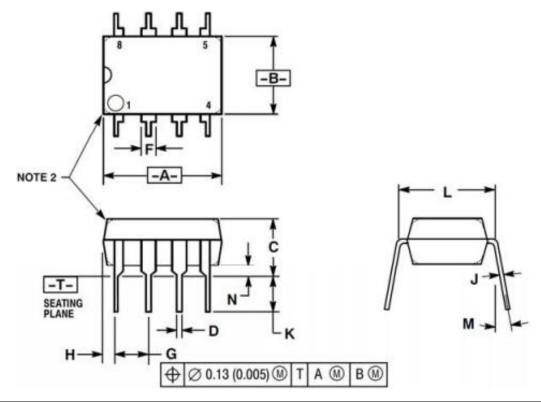




GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

6、封装尺寸与外形图

6.1、DIP-8外形图与封装尺寸



DIM	MILLIN	METERS	INCHES		
5	MIN MAX		MIN	MAX	
Α	9.40	10.16	0.370	0.400	
В	6.10	6.60	0.240	0.260	
С	3.94	4.45	0.155	0.175	
D	0.38	0.51	0.015	0.020	
F	1.02	1.78	0.040	0.070	
G	2.54	IBSC	0.100BSC		
Н	0.76	1.27	0.030	0.050	
J	0.20	0.30	0.008	0.012	
K	2.92	3.43	0.115	0.135	
L	7.62	BSC	0.300BSC		
М		10°		10°	
N	0.76	1.01	0.030	0.040	

注意:1.尺寸 L 到引线中心时形成平行

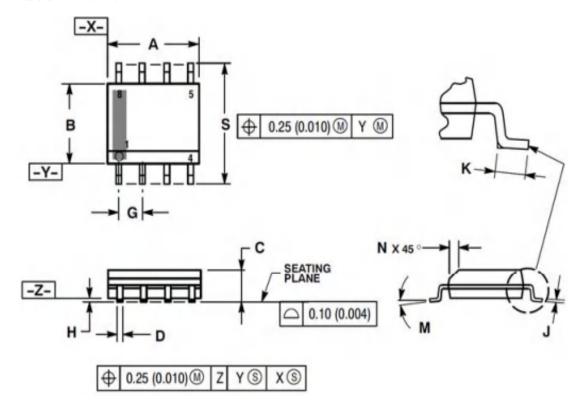
2. 封装外形可选(圆形或方角)

3. 符合 ANSI 的尺寸和公差Y14.5M, 1982



GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

6.2、SOP-8外形图与封装尺寸



DIM	MILLIN	METERS	INCHES		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
А	4.80	5.00	0.189	0.197	
В	3.80	4.00	0.150	0.157	
С	1.35	1.75	0.053	0.069	
D	0.33	0.51	0.013	0.020	
G	1.27	'BSC	0.050BSC		
Н	0.10	0.25	0.004	0.010	
J	0.19	0.25	0.007	0.010	
K	0.40	1.27	0.016	0.050	
M	0°	8°	0°	8°	
N	0.25	0.50	0.010	0.020	
S	5.80	6.20	0.228	0.244	

注意:1.符合 ANSI 的尺寸和公差Y14.5M, 1982

- 2. 控制尺寸:毫米。
- 3. 尺寸A和B不包括模具突出。
- 4. 最大模具凸出量0. 15(0.006)每面。
- 5. D尺寸不包括Dambar允许突出量阻尼器突出量总计为 0. 127(0. 005)超出 D 尺寸最大材料条件。
- 6.751-01 至 751-06 已过时。新标准是 751-07。

旌芯半导体科技(上海)有限公司

GN Semi conductor (Shanghai) Co., Ltd.

GN358HA

7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素									
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基巳 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封 树脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芯片	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装片胶	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0
说明	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考,本公司不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权 利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害 、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险,本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试,以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障 。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,本资料中的信息如有变化,恕不另行通知, 建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料,如果由本公司以外的来源提供,则本公司不对其内容负责。